

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分  
 【発行日】平成 18 年 5 月 11 日 (2006.5.11)

【公開番号】特開 2004-288439 (P2004-288439A)  
 【公開日】平成 16 年 10 月 14 日 (2004.10.14)  
 【年通号数】公開・登録公報 2004-040  
 【出願番号】特願 2003-77875 (P2003-77875)  
 【国際特許分類】

**H 0 1 L 51/50 (2006.01)**

**C 0 9 K 11/06 (2006.01)**

【F I】

H 0 5 B 33/14 B

C 0 9 K 11/06 6 5 0

C 0 9 K 11/06 6 5 5

【手続補正書】  
 【提出日】平成 18 年 3 月 17 日 (2006.3.17)  
 【手続補正 1】  
 【補正対象書類名】明細書  
 【補正対象項目名】0 0 8 4  
 【補正方法】変更  
 【補正の内容】  
 【0 0 8 4】

次に発光層 4 1 3 が形成される。なお、本実施例では、上述した構造式 ( 1 9 ) に示す  
 ホスト材料 ( T P B I ) と、上述した構造式 ( 2 0 ) に示すゲスト材料 ( クマリン 3 0 )  
 とを用いて共蒸着法により 5 0 n m の膜厚で形成する。

【手続補正 2】  
 【補正対象書類名】明細書  
 【補正対象項目名】0 0 9 0  
 【補正方法】変更  
 【補正の内容】  
 【0 0 9 0】

すなわち、基板 5 0 0 上に形成される第 1 の電極 5 0 1、正孔注入層 5 1 1、正孔輸送  
 層 5 1 2、発光層 5 1 3、および第 2 の電極 5 0 3 は、実施例 1 と同様の材料を用いるこ  
 とができる。

【手続補正 3】  
 【補正対象書類名】明細書  
 【補正対象項目名】0 0 9 1  
 【補正方法】変更  
 【補正の内容】  
 【0 0 9 1】

また、電子輸送層 5 1 4 は、発光層 5 1 3 にホスト材料として用いた構造式 ( 1 9 ) に  
 示す化合物 ( T P B I ) を用いて、蒸着法により 3 0 n m の膜厚で形成する。なお、発光  
 層 5 1 3、および電子輸送層 5 1 4 に同じ化合物を用いることにより、さらにキャリアの  
 輸送性を高めることができる。

【手続補正 4】  
 【補正対象書類名】明細書  
 【補正対象項目名】0 0 9 8  
 【補正方法】変更

## 【補正の内容】

【0098】

## (実施例4)

本実施例では、実施例2で示した素子構成を有する電界発光素子（ITO / Cu - Pc (20 nm) / - NPD (30 nm) / TPBI + クマリン30 (20 nm) / TPBI (30 nm) / CaF (2 nm) / Al) を作製し、その素子特性について測定した。なお、ITOで形成される電極サイズは2 mm × 2 mmである。また、この電界発光素子からは、発光スペクトルの最大ピークが、475 nm、CIE (x, y) = (0.152, 0.302) の青色発光が得られた。